

**Моделирование и исследование влияния радиационных факторов
на изделия микроэлектроники**

**ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЯДЕРНЫХ ЧАСТИЦ
НА ИЗДЕЛИЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ**

Оценка многократных сбоев в интегральных схемах от воздействия тяжелых заряженных частиц

А. И. Чумаков 83

Влияние топологического размещения ячеек в микросхемах памяти на кратность сбоев от ТЗЧ

А. Б. Борудина, Н. Г. Григорьев, А. В. Уланова 88

Ограничения и перспективы использования двухфазной КМОП-логики в сбоеустойчивых суб-100-нм СБИС

В. Я. Стенин 94

Моделирование характеристик триггерных элементов КМОП двухфазной логики с учетом разделения заряда при воздействии отдельных ядерных частиц

Ю. В. Катунин, В. Я. Стенин, П. В. Степанов 104

**МОДЕЛИРОВАНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ
В ИЗДЕЛИЯХ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ**

Лазерное имитационное моделирование за дифракционным пределом

П. К. Скоробогатов 118

Выбор оптимальных параметров лазерного излучения для моделирования ионизационных эффектов в кремниевых микросхемах объемной технологии

А. Ю. Никифоров, П. К. Скоробогатов, А. Н. Егоров, Д. В. Громов 127

Расчетно-экспериментальное моделирование эффектов мощности дозы в СВЧ МИС на основе гетероструктурных полевых транзисторов

В. В. Елесин 133

Использование вероятностных и нечетких моделей при моделировании радиационных отказов БИС

В. М. Барбашов, Н. С. Трушкин, К. А. Епифанцев 142

Водородно-электронная модель накопления поверхностных состояний на границе раздела окисел—полупроводник при воздействии ионизирующего излучения

А. В. Согоян, С. В. Черепко, В. С. Першенков 156

Вниманию авторов

159
